

次世代パワーエレクトロニクス技術セミナーのご案内

主催：新潟県工業技術総合研究所

地球温暖化抑制の観点から、再生可能エネルギーが注目されています。再生可能エネルギーは、より効率的な利用が求められています。電力の効率的な利用を目的として、従来のSiに代わり、SiCやGaNといった新しいパワーデバイスが注目されています。当該技術分野の第一人者の奥村氏をむかえて、新しいパワーデバイスの原理、技術動向、市場動向から応用展開にいたるまで、概観します。

セミナー

1. 日時：平成25年7月26日(金)14:00～16:00
2. 会場：新潟県工業技術総合研究所 1階 講堂(新潟市中央区鏡西1-11-1)
3. タイムスケジュール

- 1) 14:00-14:10 あいさつ 工業技術総合研究所
- 2) 14:10-14:30 研究会の進め方と報告 工業技術総合研究所
- 3) 14:30-16:00 講演、質疑応答およびディスカッション

演題 「次世代パワーエレクトロニクスの可能性」

講師：独立行政法人産業技術総合研究所・先進パワーエレクトロニクス研究センター
研究センター長 奥村 元 氏

講師紹介：20年以上にわたり、SiC、GaN等のワイドギャップ半導体及びそのエレクトロニクス応用の研究開発に従事、数多くの優れた成果を挙げてきた。発表論文約300編、学協会での招待発表多数。特許約30件。SiC、GaN、双方の材料で、産官学のプロジェクトリーダーやサブプロジェクトリーダーを務める。

4. 参加費：無料

SiC、GaNとは：従来パワーデバイス材料のSiに対して、パワーデバイスに必要な特性(1. 絶縁破壊特性、2. スイッチング特性、3. 熱伝導度など)に優れた材料のこと。

申込方法 ……下記申込書に記載し、電子メール か FAX でお申込みください。

新潟県工業技術総合研究所 研究開発センター 担当：五十嵐
〒950-0915 新潟市中央区鏡西1-11-1 TEL:025-247-1320 FAX:025-241-5018
E-mail : ik_akira@iri.pref.niigata.jp

新潟県工業技術総合研究所 研究開発センター 五十嵐 行

FAX 025-241-5018

「次世代パワーエレクトロニクス技術セミナー」申込書

会社名		
連絡先・所在地 (TEL・FAX)	〒 (TEL — — FAX — —)	
参加者名	役職名 氏名	役職名 氏名
E-mailアドレス	@	@

※ご記入いただいた情報は、新潟県からの連絡・情報提供のみ利用させていただきます。